

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成21年1月15日 (2009.1.15)

【公開番号】特開2005-223321 (P2005-223321A)

【公開日】平成17年8月18日 (2005.8.18)

【年通号数】公開・登録公報2005-032

【出願番号】特願2005-19007 (P2005-19007)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/30 5 0 2 C

G 0 3 F 7/20 5 2 1

【誤訳訂正書】

【提出日】平成20年11月18日 (2008.11.18)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 3 5

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 3 5】

例えば、低減反応メモリ特性を有する一方で高コントラストの潜像を提供することが可能なフォトレジストは、図 3 A に示すようなブロック型マトリックス構成中に光酸発生剤 (P A G)、並びに塩基 B 化合物を備えている。この構成では、露光の後で光酸発生剤 P A G が光酸 P A + に変換され、このうちの一部分は図 3 B に示したように塩基 B 化合物によって中和される。